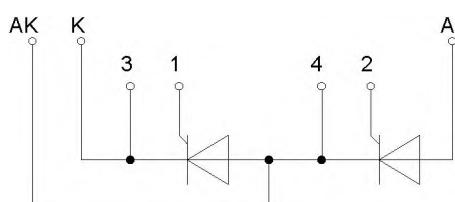
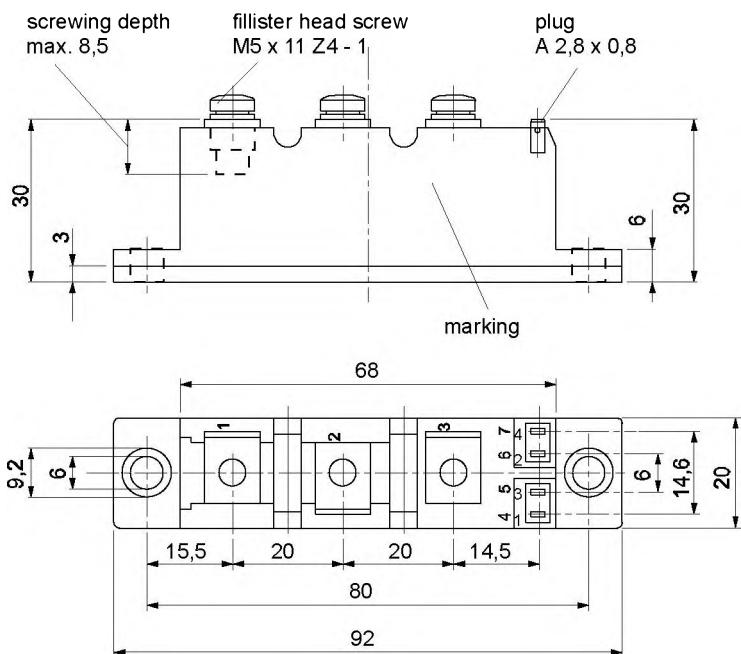


European Power-
Semiconductor and
Electronic Company

Marketing Information TT 46 N



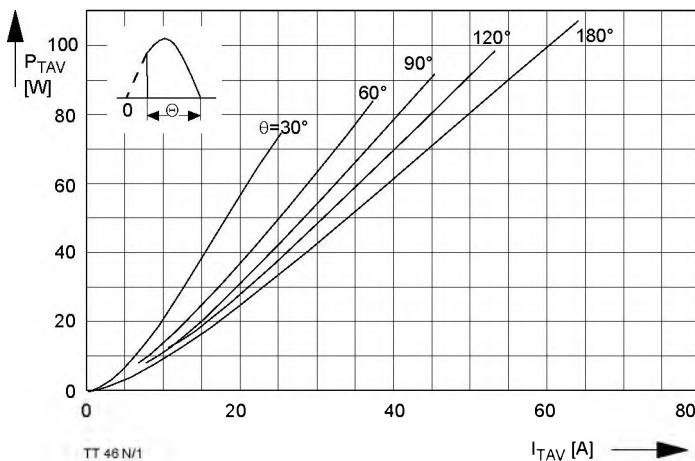


Bild / Fig. 1
Durchlaßverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
 $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

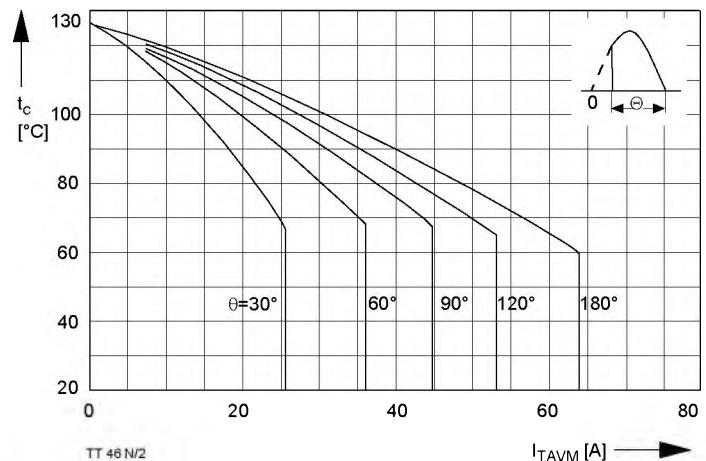


Bild / Fig. 2
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature
 $t_c = f(I_{TAVM})$
Strombelastung je Zweig / current load per arm
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

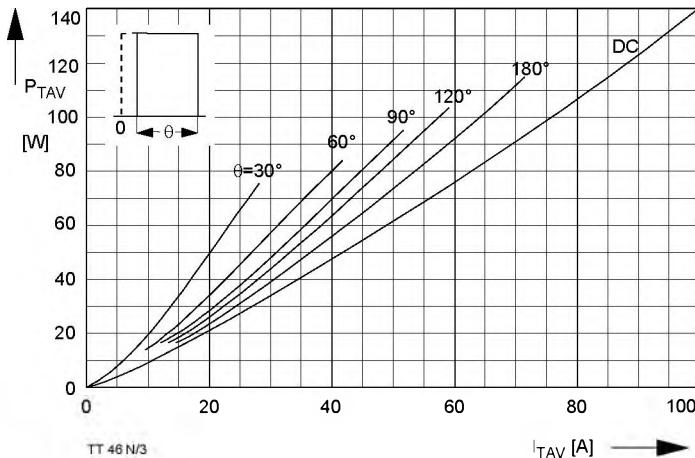


Bild / Fig. 3
Durchlaßverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
 $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

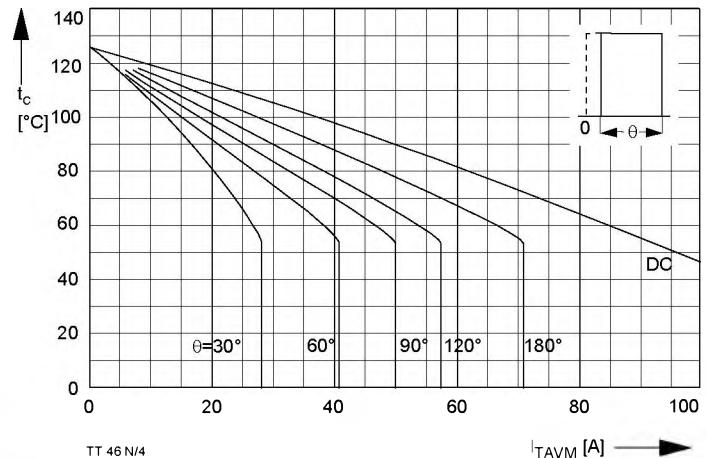


Bild / Fig. 4
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature
 $t_c = f(I_{TAVM})$
Strombelastung je Zweig / current load per arm
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

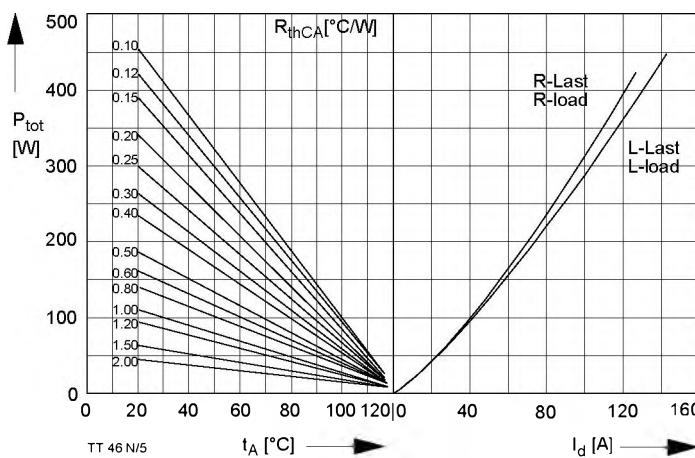


Bild / Fig. 5
B2 - Zweiplus-Brückenschaltung / Two-pulse bridge circuit
Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_d
Gesamtverlustleist. der Schaltung / total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung /
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

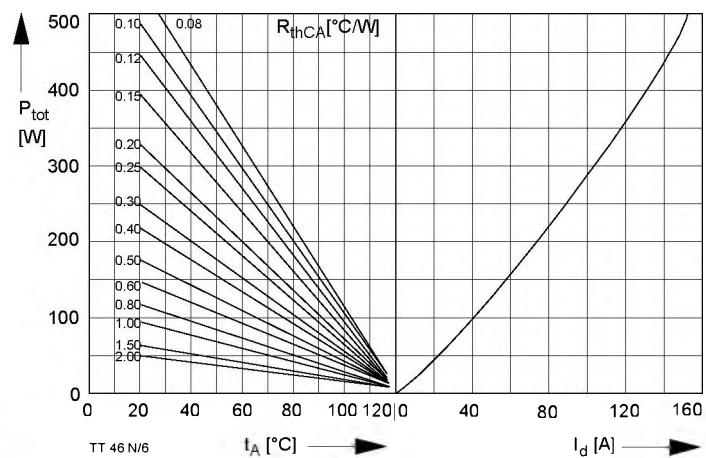


Bild / Fig. 6
B6 - Sechspuls-Brückenschaltung / Six-pulse bridge circuit
Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_d
Gesamtverlustleist. der Schaltung / total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung /
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

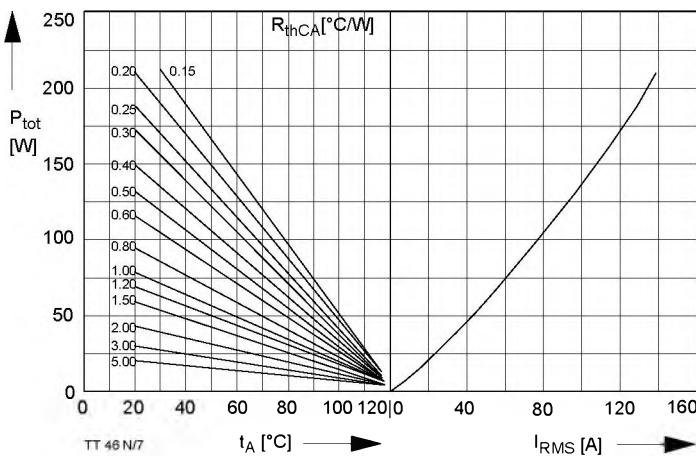


Bild / Fig. 7
W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Effektivstrom / Maximum ratet RMS current I_{RMS}
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

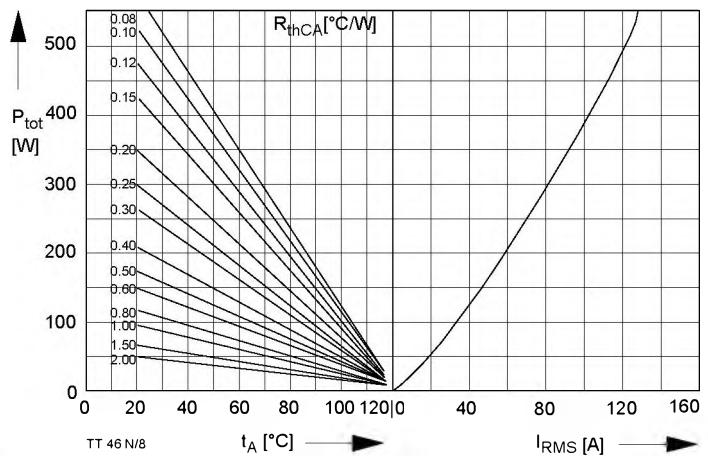


Bild / Fig. 8
W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Effektivstrom je Phase / Maximum ratet RMS current per phase I_{RMS}
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

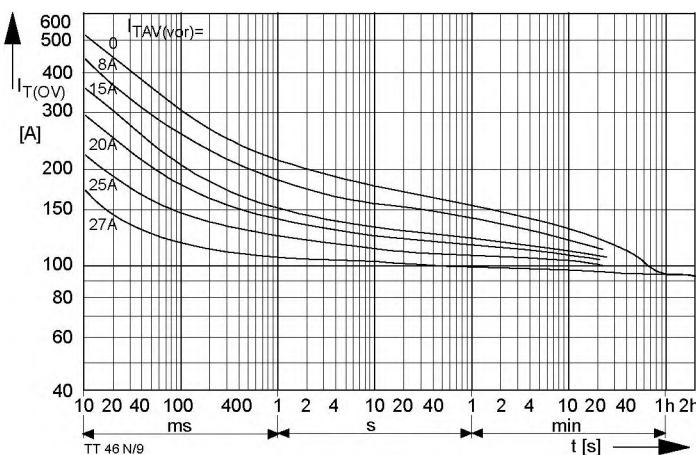


Bild / Fig. 9
B2 - Zweiplus - Brückenschaltung / Two - pulse bridge circuit
Überstrom je Zweig $I_{T(\text{OV})}$ bei Luftselbstkühlung, $t_A=45^\circ\text{C}$,
Kühlkörper KP0,33S /
Overload on-state current per arm $I_{T(\text{OV})}$ at natural cooling, $t_A=45^\circ\text{C}$,
heatsink type KP 0,33S
Parameter: Vorlaststrom je Zweig / pre-load current per arm $I_{T\text{AV}(\text{vor})}$

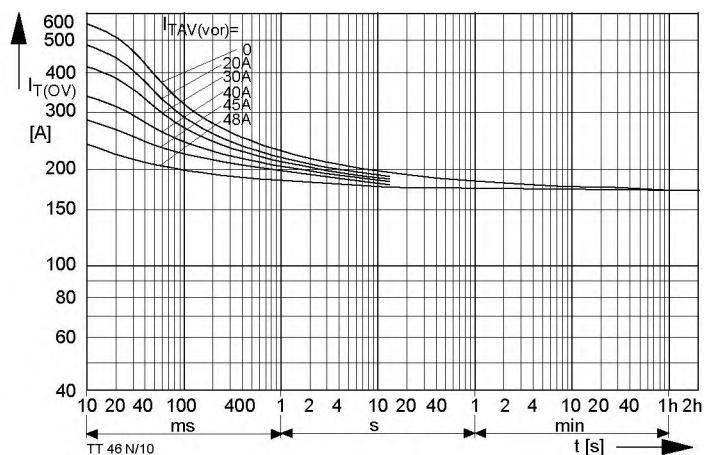


Bild / Fig. 10
B2 - Zweiplus - Brückenschaltung / Two - pulse bridge circuit
Überstrom je Zweig $I_{T(\text{OV})}$ bei verstärkter Luftkühlung, $t_A=35^\circ\text{C}$, $V_L=90\text{V}/\text{s}$,
Kühlkörper KP0,33S /
Overload on-state current per arm $I_{T(\text{OV})}$ at forced cooling, $t_A=35^\circ\text{C}$, $V_L=90\text{V}/\text{s}$,
heatsink type KP 0,33S.
Parameter: Vorlaststrom je Zweig / pre-load current per arm $I_{T\text{AV}(\text{vor})}$

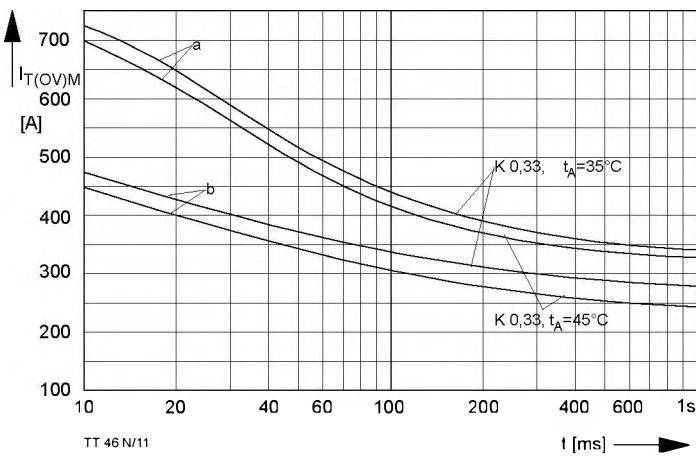


Bild / Fig. 11
Grenzstrom je Zweig $I_{T(\text{OV})M}$ bei Luftselbstkühlung, $t_A=45^\circ\text{C}$ und verstärkter
Luftkühlung, $t_A=35^\circ\text{C}$, Kühlkörper KP 0,33S, $v_{RM}=0,8 V_{RRM}$.
Limiting overload on state current per arm $I_{T(\text{OV})M}$ at natural ($t_A=45^\circ\text{C}$) and
forced ($t_A=35^\circ\text{C}$) cooling, heatsink type KP 0,33S, $v_{RM}=0,8 V_{RRM}$.
a - Belastung nach Leerlauf / current surge under no-load conditions
b - Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom $I_{T\text{AVM}}$ /
Current surge occurs during operation at limiting mean on- state current
rating $I_{T\text{AVM}}$

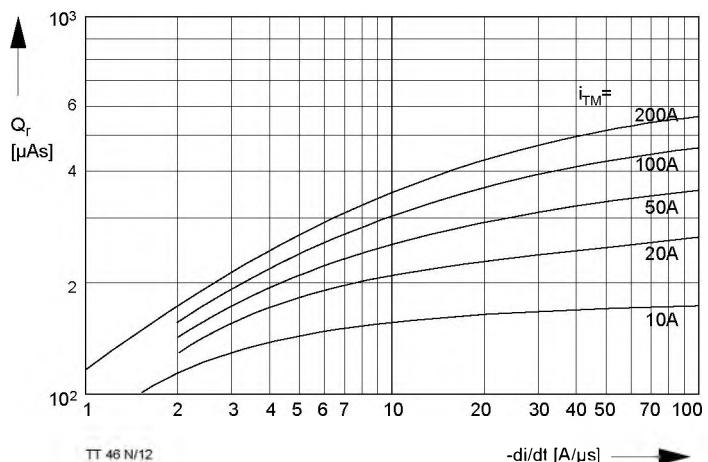


Bild / Fig. 12
Sperrverzögerungsladung / Recovery charge $Q_r = f(-di/dt)$
 $t_{vj} = t_{vj\text{max}}$, $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$
Parameter: Durchlaßstrom / On-state current i_{TM}

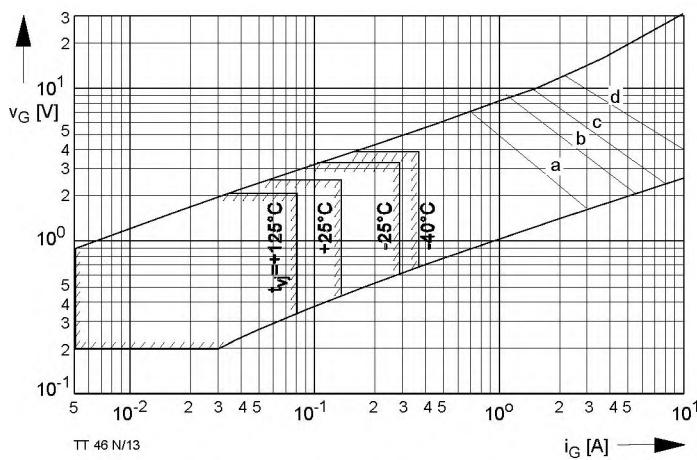


Bild / Fig. 13

Steuercharakteristik mit Zündbereichen / Gate characteristic with triggering areas, $v_G = f(i_G)$, $v_D = 6 \text{ V}$

Parameter: a b c d

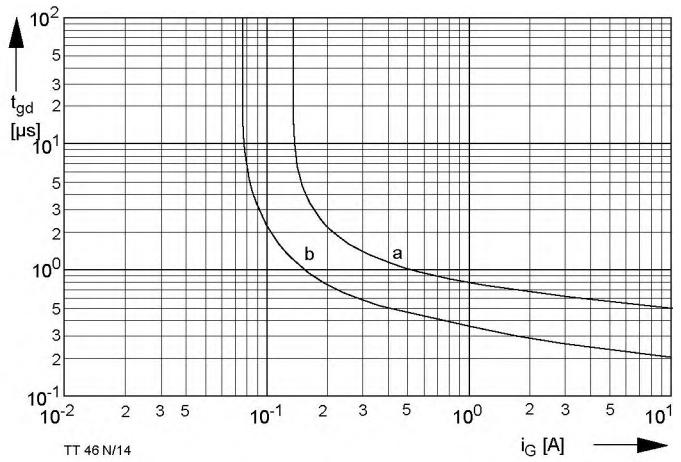
Steuerimpulsdauer / Pulse duration t_G [ms] 10 1 0.5 0.1Höchstzulässige Spitzensteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power |W| 5 10 15 30

Bild / Fig. 14

Zündverzug / Gate controlled delay time $t_{gd} = f(i_G)$ $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $di_G/dt = i_{GM}/1\mu\text{s}$

a - äußerster Verlauf / limiting characteristic

b - typischer Verlauf / typical characteristic

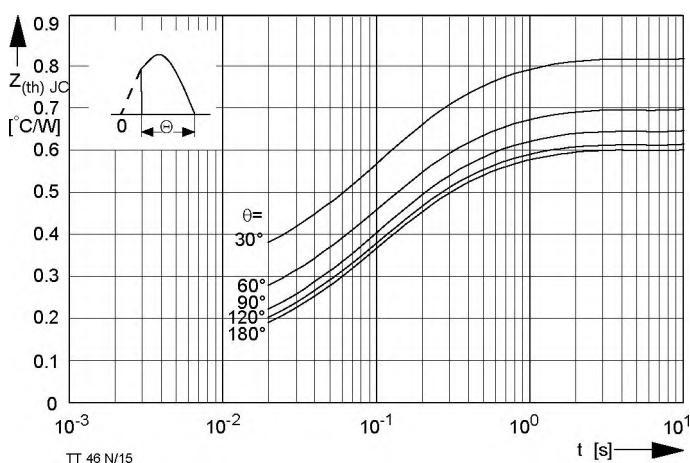


Bild / Fig. 15

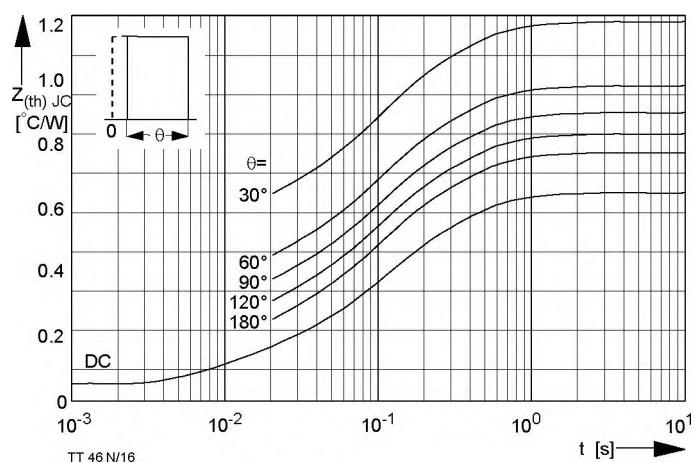
Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{(th)JC} = f(t)$ Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ 

Bild / Fig. 16

Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{(th)JC} = f(t)$ Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

| Pos. n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|----------|---------|-------|-------|-------|--------|---|
| $R_{thn} [\text{°C/W}]$ | 0,0101 | 0,0317 | 0,073 | 0,144 | 0,186 | 0,1152 | |
| $\tau_n [\text{s}]$ | 0,000044 | 0,00136 | 0,016 | 0,065 | 0,123 | 0,68 | |

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$

TT 46 N, TD 46 N, DT 46 N

| Elektrische Eigenschaften | | Electrical properties | | | |
|--|--|---|------------------------------|--|-------------------------|
| Hochstzulässige Werte | | Maximum rated values | | | |
| Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung | repetitive peak forward off-state and reverse voltages | $t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj\ max}$ | $V_{DRM}, V_{RRM}, V_{DSM}$ | 800 1200 1400 1600 | V |
| Vorwärts-Stoßspitzen-Sperrspannung | non-repetitive peak forward off-state voltage | $t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj\ max}$ | V_{DSM} | 800 1200 1400 1600 | V |
| Rückwärts-Stoßspitzen-Sperrspannung | non-repetitive peak reverse voltage | $t_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots t_{vj\ max}$ | V_{RSM} | 900 1300 1500 1700 | V |
| Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert | RMS on-state current | | I_{TRMSM} | 100 | A |
| Dauergrenzstrom | average on-state current | $t_c = 85^{\circ}\text{C}$ $t_c = 61^{\circ}\text{C}$ | I_{TAVM} | 46 64 | A |
| Stoßstrom-Grenzwert | surge current | $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10\text{ ms}$ | I_{TSM} | 1150 1000 | A |
| Grenzlastintegral | I^2t -value | $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10\text{ ms}$ | I^2t | 6600 5000 | A^2s |
| Kritische Stromsteilheit | critical rate of rise of on-state current | DIN IEC 747-6, $f = 50\text{ Hz}, v_L = 8\text{ V}$ | $(di_T/dt)_{cr}$ | 120 | $\text{A}/\mu\text{s}$ |
| Kritische Spannungssteilheit | critical rate of rise of off-state voltage | $I_{GM} = 0,6\text{ A}, di_G/dt = 0,6\text{ A}/\mu\text{s}$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, V_D = 0,67 V_{DRM}$ | $(dv_D/dt)_{cr}$ | | |
| Charakteristische Werte | | Characteristic values | 6.Kennbuchstabe/6th letter F | | |
| Durchlaßspannung | on-state voltage | $t_{vj} = t_{vj\ max}, i_T = 150\text{ A}$ | V_T | max. 1,72 | V |
| Schleusenspannung | threshold voltage | $t_{vj} = t_{vj\ max}$ | $V_{T(TO)}$ | 0,95 | V |
| Ersatzwiderstand | slope resistance | $t_{vj} = t_{vj\ max}$ | r_T | 4,5 | $\text{m}\Omega$ |
| Zündstrom | gate trigger current | $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6\text{ V}$ | I_{GT} | max.150 | mA |
| Zündspannung | gate trigger voltage | $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6\text{ V}$ | V_{GT} | max. 2,5 | V |
| Nicht zündender Steuerstrom | gate non-trigger current | $t_{vj} = t_{vj\ max}, V_D = 6\text{ V}$ | I_{GD} | max.5 | mA |
| Nicht zündende Steuerspannung | gate non-trigger voltage | $t_{vj} = t_{vj\ max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$ | V_{GD} | max. 2,5 | mA |
| Haltestrom | holding current | $t_{vj} = t_{vj\ max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$ | I_H | max.200 | mA |
| Einraststrom | latching current | $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6\text{ V}, R_A = 5\Omega$ $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6\text{ V}, R_{GK} > 10\Omega$ | I_L | max.600 | mA |
| Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom | forward off-state and reverse currents | $i_{GM} = 0,6\text{ A}, di_G/dt = 0,6\text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 20\text{ }\mu\text{s}$ $t_{vj} = t_{vj\ max}$ | i_D, i_R | max.10 | mA |
| Zündverzug | gate controlled delay time | $V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$ DIN IEC 747-6, $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $i_{GM} = 0,6\text{ A}, di_G/dt = 0,6\text{ A}/\mu\text{s}$ | t_{gd} | max. 1,2 | μs |
| Freiwerdezeit | circuit commutated turn-off time | $t_{vj} = t_{vj\ max}, i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100\text{ V}, V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20\text{ V}/\mu\text{s}, -di_T/dt = 10\text{ A}/\mu\text{s}$ | t_q | typ.80 | μs |
| Isolations-Prüfspannung | insulation test voltage | 5.Kennbuchstabe/5th letter O RMS, $f = 50\text{ Hz}, 1\text{ min.}$ RMS, $f = 50\text{ Hz}, 1\text{ sec.}$ | V_{ISOL} | 3 kV 3,6 kV | ¹⁾ |
| Thermische Eigenschaften | | Thermal properties | | | |
| Innerer Wärmewiderstand | thermal resistance, junction to case | pro Modul/per module, $\Theta = 180^{\circ}$ pro Zweig/per arm, $\Theta = 180^{\circ} \sin$ pro Modul/per module, DC pro Zweig/per arm, DC pro Modul/per module | R_{thJC} | max. 0,30 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ max. 0,60 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ max. 0,28 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ max. 0,56 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ | |
| Übergangs-Wärmewiderstand | thermal resistance, case to heatsink | pro Zweig/per arm | R_{thCK} | max. 0,08 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ | |
| Höchstzul. Sperrschiichttemperatur | max. junction temperature | $t_{vj\ max}$ | | 125 | $^{\circ}\text{C}$ |
| Betriebstemperatur | operating temperature | $t_{c\ op}$ | | -40...+125 | $^{\circ}\text{C}$ |
| Lagertemperatur | storage temperature | t_{stg} | | -40...+130 | $^{\circ}\text{C}$ |
| Mechanische Eigenschaften | | Mechanical properties | | | |
| Gehäuse, siehe Seite | case, see page | | | | 1 |
| Si-Elemente mit Lötkontakt, glaspassiviert | Si-pellet with soldered contact, glass-passivated | | | | |
| Innere Isolation | internal insulation | | | | Al_2O_3 |
| Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung | mounting torque | Toleranz/tolerance +/- 15% | M1 | 4 | Nm |
| Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse | terminal connection torque | Toleranz/tolerance +5%/-10% | M2 | 4 | Nm |
| Gewicht | weight | | G | typ. 125 | g |
| Kriechstrecke | creepage distance | | | 12,5 | mm |
| Schwingfestigkeit | vibration resistance | $f = 50\text{ Hz}$ | | 50 | m/s^2 |
| Kühlkörper / heatsinks: KP 0,5 S; KP 0,41 S; KP 0,35 S; KP 0,33 S | | | | | |

¹⁾ nur gültig für 4.Kennbuchstaben L / only valid with 4th letter L